

GaN研究コンソーシアム スプリングスクール開催のご案内

平成 28 年 11 月
GaN 研究コンソーシアム事務局

GaN 研究コンソーシアムは、産学官の共創場での実践的教育を通して、高い専門性と俯瞰的な視点を兼備し、社会のための科学 (Science for Society) を志向する、21 世紀型の若手研究者・技術者の育成に努めることにしています。

これを踏まえて、我が国の GaN 研究開発の将来を担う優秀な人材を育成するため、大学院生、ポストドクター研究員、社会人を対象として、スプリングスクールを開講します。本スクールでは、GaN の結晶成長、デバイスプロセスに関する専門的技術の理解、及びビジネスモデルに関する基礎的知識の修得を目的とした講義、及びチームビルディング等のグループ研修を通じた交流を行います。

◆開催日 **2017年3月23日(木)・24(金)**

◆場所 **名古屋大学(東山キャンパス) ES総合館1階ES会議室**

(<http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html>)

◆対象者 **GaN 研究コンソーシアムの会員である機関に所属する大学院生、
ポストドクター研究員、社会人**

※会員ではない機関からの参加希望があった場合、会員機関の参加を優先し、定員の範囲内で認めます。

◆募集人数 **70名**

◆募集期間 **2017年2月24日(金)まで**

※応募者が定員に達した場合、募集を締め切ります。
早めにご応募ください。

◆参加費 **《GaN 研究コンソーシアムの会員機関》**

各機関1名まで無料。それを超える場合は、一人 1万円。
※大学院生は交通費・宿泊費として実費を補助します(最大3万円)

《GaN 研究コンソーシアムの会員ではない機関》

一人 5万円

◆プログラム **【別紙1】を参照ください。**

1日目の夕方に
交流会を開催します。
※交流会参加費(別途)
1,000円

スクール長
天野 浩

名古屋大学
未来エレクトロニクス
集積研究センター
教授・センター長

参加申し込み方法

下記スクール事務局に、電子メールでご連絡ください。
申し込みの際は、①参加者氏名 ②所属機関 ③職業(学生または役職) ④年齢 ⑤連絡先(電話番号とメールアドレス) ⑥交流会参加の可否 を明記ください。
集合場所・時間等の詳細は参加登録後にメールでご連絡します。
個人情報をご本スクール参加登録以外の目的で使用すること、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】 GaN 研究コンソーシアム/スプリングスクール事務局

E-MAIL: gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp (電話 052-747-6584)

【事務局メンバー】 名古屋大学

研究協力部社会連携課: 加藤 史征

学術研究・産学官連携推進本部 企画戦略グループ: 佐藤 浩哉、笹岡 千秋、山口 淳

GaN研究コンソーシアム スプリングスクール プログラム

【第一日目】 3月23日(木) 専門的技術（基礎）

(氏名は敬称略)

時 間	内 容	講 師
10:00～10:10	スクール長・天野教授 御挨拶	天野 浩 (名大)
10:10～10:30	オリエンテーション	
10:30～12:00	GaN電子デバイスの動作原理と特徴	加地 徹 (名大)
 昼 食 (各 自)		
13:00～14:30	GaN光デバイスの動作原理と特徴	新田 州吾 (名大)
14:45～16:15	GaN結晶成長法とその原理	松本 功 (大陽日酸)
16:30～18:00	GaNパワーデバイスの現状	葛原 正明 (福井大)
18:15～20:00	交流会	

【第二日目】 3月24日(金) 専門的技術（応用）、ビジネスモデル、グループ研修

時 間	内 容	講 師
8:45～10:15	GaN光デバイスの現状	牛田 泰久 (名大)
10:30～12:00	GaN高周波デバイスとその応用	柳生 栄治 (三菱電機)
 昼 食 (各 自)		
13:00～14:30	ビジネスモデル	深井 昌克 (名大)
14:45～17:30	グループ研修	深井 昌克 (名大)
17:45～18:00	修了式	